Fe/Cr 多層膜の XAFS による構造解析 Structural analysis of Fe/Cr multilayer films by XAFS

池田優里亜^{1,*},高杉孝樹¹,宮永崇史¹

¹弘前大学理工, 〒036-8224 青森県弘前市文京町 3 Yuria Ikeda, Kouki Takasugi, Takafumi Miyanaga Hirosaki Univ. Science and technology, 3 Bunkyou-cho, Hirosaki, Aomori, 036-8561, Japan

1 <u>はじめに</u>

Fe/Cr 多層膜の特徴的な性質の一つとして巨大磁 気抵抗効果(Giant-Magneto-Resistance:GMR)が挙げら れる。1988年にフランスの Baibich によって、BCC 構造を示す Fe/Cr 人工格子薄膜は非磁性金属膜(スペ ーサー)を介した磁性層間の交換結合がスペーサー の膜厚と共に、大きな抵抗値を示すスピン依存散乱 が行われる結合形人工格子であると報告された。こ れに伴い、磁性層と非磁性層間で RKKY 相互作用な どによる交換相互作用が解明され、GMR が出現し た。金属人工格子薄膜は Co/Cu 人工格子薄膜など他 にも存在するが、Fe/Cr 人工格子薄膜は室温中で高 い電気抵抗率を示す。通常の金属では、数%しか電 気抵抗率を示さないが、スペーサーを介して Fe 層 が反平行に結合しているため、Fe/Cr 人工格子薄膜 は外部磁場を印加することなく、10数%という高い 電気抵抗率を示す。この Fe/Cr 人工格子薄膜による GMR は、近年の記録密度の向上に大いに貢献して いる。[1]

現在、このような多層膜は記録媒体などの MRAM や磁気センサなど、数多くのナノテクノロ ジーに用いられている。その点で金属多層膜の高保 磁力化が求められているが、保磁力の詳細なメカニ ズムは未だに明らかになっていない。

これまで当研究室では、Fe/Cr 多層膜の Debye-Waller 因子が小さくなると保磁力が増加することが 分かっていた。[2]そこで今回の研究では、多層膜の 膜厚を変化させた場合、使用基板を変えた場合での 膜原子の局所構造の違いについて着目し、Fe と Cr について XAFS 解析を行った。

2 <u>実験</u>

今回測定した Fe/Cr 多層膜は RF マグネトロンス パッタ法により総膜厚 300nm で作製され、磁化測定 および保磁力の評価は振動試料型磁力計を用いた。 測定に用いた試料と保磁力を Table に示す。XAFS 測定は KEK-PF で行い、ガラス基板は BL9C、MgO 基板は BL12C にて蛍光法(ライトル検出器)で測 定した。また、吸収端はそれぞれの基板の Fe Kedge、Cr K-edge である。EXAFS の解析方法につい ては、Athena と Artemis を用いて解析した。[3]その 一例として Fig.1、Fig.2 はそれぞれガラス基板 Fe Kedge の $k^3 \chi(k)$ スペクトルとフーリエ変換スペクトル である。ピーク周期に大きなずれは無いが、ピーク 強度は膜厚によって異なっていることがわかる。今 回はフーリエ変換スペクトルの第一ピークについて カーブフィッティングを行い、第一近接、第二近接 原子についての原子間距離と Debye-Waller 因子を求 めた。その際、カーブフィットは等方膨張を仮定し て行った。

Table 作製試料と保磁力

基板	膜厚と膜数	保磁力 (Oe)
ガラス 基板	Fe(100nm)/Cr(100nm)/Fe(100nm)	27.5
	${Fe(25nm)/Cr(25nm)} \times 6layers$	29.0
	${Fe(10nm)/Cr(10nm)} \times 15$ layers	33.5
MgO 基板	Fe(100nm)/Cr(100nm)/Fe(100nm)	20.0
	${Fe(25nm)/Cr(25nm)} \times 6layers$	25.0
	${Fe(10nm)/Cr(10nm)} \times 15$ layers	32.0



Fig.1: ガラス基板 Fe K-edge $k^3 \chi(k)$ スペクトル。



Fig.2: ガラス基板 Fe K-edge フーリエ変換スペクトル。

3 結果および考察

解析により求めた原子間距離と Debye-Waller 因子の第一近接原子についての結果を用いて考察する。

まず、膜厚と原子間距離について Fig.3 を見ると、 膜厚が厚くなるにつれて原子間距離がわずかに長く なっていることが分かる。また、MgO 基板の Fe と Cr の原子間距離がガラス基板上のものより長くなっ ている。これは MgO 基板を用いたことによってエ ピタキシャル成長が起こったためと考えられる。し かし、エピタキシャル成長で歪んだ原子配列は、基 板から遠ざかるにつれてもとの原子間距離に戻るは ずであり、膜厚を厚くすると原子間距離が短くなる と考えられる。この点で今回の結果と相違点が見ら れたため、フィッティング方法の再検討が必要であ る。



Fig.3: 膜厚変化による原子間距離の変化。

次に、膜厚と Debye-Waller 因子について Fig.4 を 見ると、膜厚を厚くすることで Debye-Waller 因子が 大きくなった。このことから、膜厚が厚い場合では 構造の乱れが大きくなったことが分かる。また、 MgO 基板では Debye-Waller 因子の変化が大きくな っているが、これはエピタキシャル成長によって原 子間距離が長くなっているために、原子のばらつき が大きくなったと考えられる。



Fig.4: 膜厚変化による Debye-Waller 因子の変化。

4 <u>まとめ</u>

多層膜の膜厚を変化させた場合、膜厚を薄くした ころ、原子間距離が短くなり、Debye-Waller 因子も 小さくなったことから、磁気モーメントの相関が大 きくなり、単磁区構造に近い構造をとっていると考 えられる。よって膜厚が薄い場合では保磁力が大き くなったと思われる。また、基板を変えた場合では、 MgO 基板を用いるとエピタキシャル成長により、原 子間距離が引き伸ばされてしまうため、構造が乱れ、 保磁力が小さくなったと考えられる。しかし、今回 は等方膨張を仮定したが、エピタキシャル成長を考 慮すると、原子の配列は等方的ではなくなるため、 (110)方向や(111)方向に歪む膨張についてもフィッ ティングを行うことが今後の課題である。

参考文献

[1]Y.U.Idzerada,L.H.Tjeng,H.J.Lin,C.J.Guierrez,G.Meigs, C.T.Chen, *Surface Science*, **287-288**, (1993) 741-746. [2]T. Miyanaga, K. Takasugi, T. Ohba, T. Aida, T. Okazaki, Magnetic and local structure analysis for Fe/Cr multilayer films, J. Phys. Conf. Ser, **502**, 012032 (2014).

[3] https://bruceravel.github.io/demeter/

* h17ms201@hirosaki-u.ac.jp